

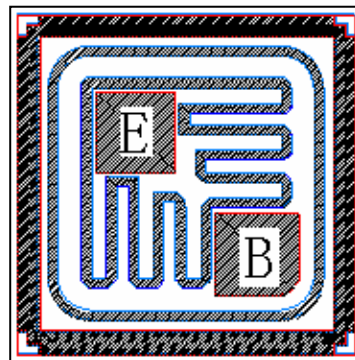


5401 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：A043BJ-01
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：430×430μm²
 焊位尺寸：B 极 107×107μm²，E 极 101×101μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2N5401，H5401

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极耗散功率..... 625mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压..... -160V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压..... -150V
 V_{EBO}——发射极—基极电压..... -5V
 I_C——集电极电流..... -600mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

| 参数符号 | 符号说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|----------------------|-------------|------|-----|-------|-----|--|
| I _{CBO} | 集电极—基极截止电流 | | | -0.05 | μA | V _{CB} =-120V, I _E =0 |
| I _{EBO} | 发射极—基极截止电流 | | | -0.05 | μA | V _{EB} =-3V, I _C =0 |
| h _{FE} | 直流电流增益 | 30 | | | | V _{CE} =-5V, I _C =-1mA |
| | | 60 | | 280 | | V _{CE} =-5V, I _C =-10mA |
| | | 50 | | | | V _{CE} =-5V, I _C =-50mA |
| V _{CE(sat)} | 集电极—发射极饱和电压 | | | -0.2 | V | I _C =-10mA, I _B =-1mA |
| | | | | -0.5 | V | I _C =-50mA, I _B =-5mA |
| V _{BE(sat)} | 基极—发射极饱和电压 | | | -1 | V | I _C =-10mA, I _B =-1mA |
| | | | | -1 | V | I _C =-50mA, I _B =-5mA |
| BV _{CBO} | 集电极—基极击穿电压 | -160 | | | V | I _C =-100μA, I _E =0 |
| BV _{CEO} | 集电极—发射极击穿电压 | -150 | | | V | I _C =-1mA, I _B =0 |
| BV _{EBO} | 发射极—基极击穿电压 | -5 | | | V | I _E =-10μA, I _C =0 |
| f _T | 特征频率 | 100 | | 400 | MHz | V _{CE} =-10V, I _C =-10mA f=100MHz |